

2018年7月26日

IEEE EDS Japan Chapter 会員各位
IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位
IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位
IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Chapter
Chair 西山 彰
Vice Chair 平本 俊郎

IEEE EDTM 報告会開催のお知らせ

2018年3月に神戸で行われました IEEE, EDS, 2nd Electron Devices Technology and Manufacturing (EDTM) Conference 2018 (<http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2018/>) について下記の通り、日本語による報告会を開催致します。奮って御参加下さい。

なお、次回は2019年3月12日から15日にシンガポールで開催される予定で、論文投稿締め切りは2018年10月15日です。IEEE Xploreに掲載され、J-EDS special issue も発行される予定です。 (<http://ewh.ieee.org/conf/edtm/2019/>)

*****IEEE EDTM 2018 報告会*****

- 日時：2018年8月2日木曜日 13:30-16:45
- 会場：東工大・田町キャンパス・国際会議室
- 参加費：無料、どなたでも参加可能です。

<https://www.titech.ac.jp/maps/tamachi/>

<http://www.tamachi.jim.titech.ac.jp/cic/images/room00.jpg>

■プログラム：

13:30-13:35	EDTM2018 全体説明	若林整・東工大
13:35-13:50	プログラム全体説明	石丸一成・東芝メモリ
13:50-14:05	Subcommittee on Devices のトレンド、	齋藤真澄・東芝メモリ
14:05-14:20	Subcommittee on Package のトレンド	栗田洋一郎・東芝
14:20-14:35	Subcommittee on Process のトレンド	三浦真・日立ハイテクノロジーズ
14:35-14:50	Subcommittee on Material のトレンド	若林整・東工大
14:50-15:05	Tutorials/Short Course の紹介	秋永広幸・産総研
15:05-15:15	休憩	
15:15-15:30	"Electrode material dependence of resistive switching behavior in Ta2O5 resistive analog neuromorphic device" の紹介	秋永広幸・産総研
15:30-15:45	"Direct Observation of Chemical States in ReRAM by Laser-based Photoemission Electron Microscopy" の紹介	秋永広幸・産総研
15:45-16:00	"Origin of High Mobility in InSnZnO MOSFETs " の紹介	池田圭司・東芝メモリ
16:00-16:15	"Top gate Sputtered MoS2 FET" の紹介	若林整、松浦賢太郎・東工大
16:15-16:30	"P/n-stacked NW on FinFET" の紹介	若林整・東工大
16:30-16:45	EDTM2019 の紹介	石丸一成・東芝メモリ
16:45	終了	

お問い合わせ先：

若林整（東京工業大学）

wakabayashi.h.ab@m.titech.ac.jp

三谷祐一郎（東芝メモリ）

yuuichiro.mitani@toshiba.co.jp

IEEE EDS Japan Chapter ホームページ：

<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>